科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 28 年 4 月 22 日現在

機関番号: 82626 研究種目: 若手研究(B) 研究期間: 2013~2015

課題番号: 25790044

研究課題名(和文)熱活性領域におけるスピントルク磁化ダイナミクスの理論的研究

研究課題名(英文)Theoretical study on spin torque induced magnetization dynamics in thermally

activated region

研究代表者

谷口 知大 (Taniguchi, Tomohiro)

国立研究開発法人産業技術総合研究所・スピントロニクス研究センター・研究員

研究者番号:90635806

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,400,000円

研究成果の概要(和文):本研究はナノ強磁性多層膜においてスピントルクと熱揺らぎの競合によって生じる磁化ダイナミクスの理論を確立することを目指して行った。磁化の運動方程式を解くことで確率的な磁化反転公式を導出した。これはナノ強磁性体の熱擾乱耐性の定量的評価手法の確立に大きく貢献するものである。またスピントルク発振やマイクロ波アシスト磁化反転といった別の物理現象への応用が可能であることも示した。

研究成果の概要(英文): The purpose of this research is to develop a theory of magnetization dynamics in nanostructured ferromagnetic multilayer in the presence of both spin transfer torque and thermal fluctuations. Solving the stochastic equation of motion of the magnetization, we derive a formula of the switching probability of the magnetization in thermally activated region excited by spin torque. This theory will enable to establish method to evaluate the thermal stability of the ferromagnet with high accuracy. It was also found that the present theory can be applied to other phenomena, such as spin torque oscillator and microwave assisted magnetization reversal.

研究分野: 磁性

キーワード: スピントロニクス 理論 スピントルク

1.研究開始当初の背景

本研究を開始した当初はナノ強磁性多層 膜における熱活性領域での磁化ダイナミ。 軍発性磁気メモリに代表されるスピント 軍発性磁気メモリに代表されるスピント によって著しく低下する。この問題を解ント によって著しな低下する。この問題をピントによって であためには熱活性領域においてスピントルクによって 理論では素子に比較的大きな電流といるに対して で対し、従来の理論は電流が極めていさい に対し、従来の理論は電流が極めているより に対して変換を解析することの 理論を使って実験を解析することの 理論の であった。

2.研究の目的

本研究の目的は実験の解析・予測に適用可能な熱活性領域におけるスピントルク磁化ダイナミクスの理論を構築することである。上記 1.に記載した通り、本研究を開始する以前の先行研究はナノ強磁性多層膜に注入する電流が極めて小さいという、実際の実験状況に合わない仮定の下で構築されているにも関わらず、様々な実験の解析に使用されてきた。これに対し本研究では、先行研究の枠組みを越えて、実験の状況に適合した理論を作ることを目指した。

3.研究の方法

一般に磁化ダイナミクスは2変数の非線形連立微分方程式で記述され、それを正確に解くことは極めて難しい。熱揺らぎというランダムな外力を含めれば解析の難しさは更に増す。しかし変数変換によって変数を時間に遅く変化する量(エネルギー)と早く変的で遅動方程式を平均化すれば解析は比較して運動方程式を平均化すれば解析は比較的簡単になる。本研究ではこの手法を応用し、平均化された運動方程式を解析的に解くことでスピントルク磁化反転確率といった実験と直接比較できる量の導出を行った。

4. 研究成果

本研究の成果は主に以下の3つである。

(1) 熱活性領域におけるスピントルク磁化反転の理論の確立

磁 化 の 運 動 方 程 式 お よ び Fokker-Planck 方程式を解くことで熱活性領域におけるスピントルク磁化反転の反転確率の公式を導出することに成功した。この手法が先行研究と大きく異なるのは、非線形な運動方程式を厳密に解くことで、ナノ強磁性多層膜に注入される電流が大きい場合にも適用可能な理論が確立された点である。

従来の理論研究では磁化の安定点近傍 で運動方程式を線形化し、そこでのスピ ントルクと熱揺らぎの競合にのみ注目す ることで磁化の反転確率の公式を導出し ていた。しかしこのような線形化が許さ れるのは素子に印加する電流が極めて小 さく、従って磁化が安定点からほとんど 動かないような場合だけである。一方、 実験で観測されるのはある安定状態から 別の安定状態への磁化反転であり、初期 の安定点近傍のダイナミクスはその一部 にすぎない。これに対し本研究では磁化 の運動方程式を非線形領域まで解くこと で磁化の反転過程全体を包括する解を導 出することに成功した。この解析を行う にあたって上記3.に述べたような運動方 程式の平均化というアプローチを見出し たことが大きな助けとなった。

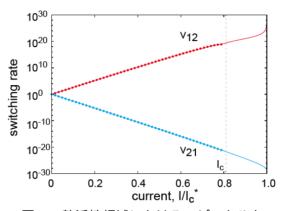


図 1: 熱活性領域におけるスピントルク 磁化反転の反転レイトの電流依存性。下 記 5.「主な発表論文」 より抜粋。

本研究の成果の一例を図1に示す。こ の図では 2 つの安定状態(1,2 と名付け る)の間の反転レイト(単位時間当たりの 反転確率)の電流依存性が示されている。 電流値が臨界電流(絶対零度での磁化反 転電流)の80%程度以下では反転レイトは 電流に対して対数スケールで線形である。 先行研究は全てこの比が小さい(80%程度 以下)の場合のみに着目しており、電流依 存性が線形であるという結果が電流の大 きな(80%以上)ところでも成り立つと仮 定していた。一方、本研究では比が大き なところ(80%以上)のところまで定量的 に反転レイトが評価できるようになった。 図 1 からわかるように電流の大きなとこ ろでは反転レイトの電流依存性は非線形 であり、先行研究の仮定は成り立ってい ないことが分かる。このように、先行研 究の限界を指摘し、それを越える理論を 構築したことな国内外で初めての成果で ある。

図 1 からわかるように、電流の値が少しでも変化すると反転レイトは大きく変化する。これは実験で反転を観測するのに必要な時間が桁で変化することを意味する。実験で反転確率を評価するには 10⁵ 回もしくはそれ以上の反転を測定するの

現在、実験で作成されている素子には 膜の不均一性等に起因する素子間のはら うきが原因で、理論との比較が直接は えないのが実情である。しかし今後、で なる実験技術の進展により、高精度で なる素子が作成できるようになれば、可 は になると考えられる。またその成果がよ ピントロニクス・デバイスの精密なせ 評価および実用化を飛躍的に前進させる ことが期待される。

(2) スピントルク自励発振の理論構築

研究当初には予期していなかったこと であるが、本研究を進める過程で、上記 (1)で確立した理論が別の物理現象の解 析にも適用できることが明らかとなった。 その一例がスピントルク磁化発振である。 スピントルク磁化発振とは、熱活性領域 における磁化反転に必要な電流よりも更 に大きな電流を素子に注入することで、 スピントルクが磁性体の磁気緩和を打ち 消し磁化の定常的な歳差運動が実現させ る現象を指す。ある安定状態から別の安 定状態へと遷移する磁化反転と一定のエ ネルギー状態にとどまる発振とは一見す ると異なる現象のように見えるが、上記 3. で述べたように熱活性領域における磁 化反転では磁化のエネルギーは遅く変化 する変数であるため、発振との関連性を 見出すことができるのである。

量的に見積もった。この結果を既存の実験と比較するとよく一致することが確かめられた。また、現在の実験値より数倍の電流を素子に印加すれば、線幅が 2-3 桁細くなることが理論的に予測された。

(3) マイクロ波アシスト磁化反転の反転条件 の導出

研究開始当初に予期していなかったも う一つの成果としてマイクロ波アシスト 磁化反転の解析が挙げられる。マイクロ 波アシスト磁化反転とはナノ強磁性体に マイクロ波と直流磁場を印加することで 磁化反転を起こす現象であり、超高密度 磁気記録素子の書き込み技術への応用が 期待されている。強磁性体がナノスケー ルまで小さくなると素子の熱耐性を保つ ために大きな磁気異方性を持った材料を 使わなければならなくなる。一方で異方 性が大きくなると書き込みの際に大きな 直流磁場を作らなければならないが、そ のような磁場をナノスケールの記録ビッ トに、しかも周りのビットに影響を与え ずに、印加するのは極めて困難である。 マイクロ波アシスト磁化反転ではあらか じめ記録ビットである磁性体にマイクロ 波を照射して磁気共鳴を誘起しておくこ とで、反転に必要な直流磁場の大きさを 低減するものである。このような現象は 実験および数値シミュレーションで確認 されていたが、効率的に反転を行うため の条件等は不明であった。

 ある。今後はあらかじめ理論的に磁化の 反転条件を予測することができるように なり、素子設計が高効率で行えるように なる。

スピントルクとの類似性からマイクロ 波アシスト磁化反転の反転条件を導出し たのは国内外で初の成果であり、しかも それが数値シミュレーションとよい一致 を得たことは磁気記録の研究に大きなイ ンパクトがある。一方で今後は本研究成 果に統計学のアイディアを導入すること が必要になると考えらえる。なぜなら既 存の実験ではどうしてもビット間に材料 パラメーターのばらつきが生じているか らである。本成果はこのような更なる課 題の解決にも適用できると考えられる。

5 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計 12件)

谷口知大、伊藤貴博、内海裕洋、常木澄 人、久保田均、Stable oscillation in spin torque oscillator excited by a small in-plane magnetic field, Journal of Applied Physics、査読有、118 巻、 2015 053903-1~7

DOI:10.1063/1.4927621

谷口知大、Nonlinear analysis of magnetization dynamics excited by spin Hall effect、Physical Review B、査読 有、91 巻、2015、104406-1~6、 DOI:10.1103/PhysRevB.91.104406 谷口知大、Linewidth of power spectrum originated from thermal noise in spin torque oscillator, Applied Physics Express、查読有、7巻、2015、053004-1~4、 DOI:10.7567/APEX.7.053004 谷口知大、今村裕志、Current dependence of spin torque switching rate based on Fokker-Planck approach, Journal of Applied Physics、 査読有、115 巻、2014、

17C708-1~3, DOI:10.1063/1.4860944 谷口知大、内海裕洋、今村裕志、Thermally activated switching rate of a nanomagnet in the presence of spin torque、Physical Review B、査読有、88 2013 \ 214414-1~6 DOI:10.1103/PhysRevB.88.214414

[学会発表](計 8件)

谷口知大、伊藤貴博、内海裕洋、常木澄 人、久保田均、Steady precession of perpendicular magnetization in ferromagnet by spin torque and in-plane magnetic field International Colloquium on Magnetic Films and Surface (ICMFS 2015), 2015 年7月16日、クラクフ(ポーランド)

谷口知大、三谷誠司、林将光、Critical current of magnetization dynamics excited by spin-Hall torque in the presence of transverse magnetic field, 第 62 回応用物理学会春季学術講演会、 2015年3月12日、東海大学(神奈川県平 塚市)

谷口知大、今村裕志、Current dependence of spin torque switching rate based on Fokker-Planck approach 58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials、2013年11月6日、デンバー (アメリカ合衆国)

[図書](計 0件)

[産業財産権]

出願状況(計 0件)

取得状況(計 0件)

[その他]

6. 研究組織

(1)研究代表者

谷口知大(TANIGUCHI, Tomohiro)產業技

術総合研究所・研究員 研究者番号:90635806